

## Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Якимов Евгений Борисович
2	Дата рождения (полная)	17 ноября 1947 г.
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук, специальность – 01.04.10
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Институтская, д. 6 <a href="http://www.iptm.ru">http://www.iptm.ru</a> <a href="mailto:eagle@iptm.ru">eagle@iptm.ru</a>
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
	Ведомственная принадлежность организации	РАН
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	Лаборатория локальной диагностики полупроводниковых материалов
	Должность	Главный научный сотрудник
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alexander Y. Polyakov, Vladimir I. Nikolaev, Eugene B. Yakimov, Fan Ren, Stephen J. Pearton and Ji Hyun Kim, "Deep level defect states in <math>\beta</math>-, <math>\alpha</math>-, and <math>\epsilon</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> crystals and films: Impact on device performance", JOURNAL OF VACUUM SCIENCE &amp; TECHNOLOGY A, 40, 020804 (2022).</li> <li>2. P. S. Vergeles, Yu. O. Kulanchikov, A. Y. Polyakov, E. B. Yakimov, S. J. Pearton, "Communication—Electron-Beam Stimulated Release of Dislocations from Pinning Sites in GaN", ECS Journal of Solid State Science and Technology 11.1, 015003, (2022)</li> <li>3. In-Hwan Lee, Tae-Hwan Kim, A.Y. Polyakov, A.V. Chernykh, M.L. Skorikov, E.B. Yakimov, L.A. Alexanyan, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, S.J. Pearton "Degradation by sidewall recombination centers in GaN blue micro-LEDs at diameters &lt;30 <math>\mu</math>m", Journal of Alloys and Compounds 921, 166072, (2022)</li> <li>4. V. I. Orlov, A.Y. Polyakov, P. S. Vergeles, E. B. Yakimov, Gyu Cheol Kim, In-Hwan Lee, "Estimations of activation energy for dislocation mobility in p-GaN", ECS Journal of Solid State Science and Technology 10.2, 026004 (2021):</li> <li>5. Eugene B. Yakimov, Pavel S. Vergeles, Alexander Y. Polyakov, Ivan V. Shchemerov, A.V. Chernykh, A.A. Vasilev, A.I. Kochkova, In-Hwan Lee, S.J. Pearton, "Dislocations introduced in n-GaN at room temperature cause conductivity inversion", Journal of Alloys and Compounds 877; 160281 (2021)</li> <li>6. P. S. Vergeles, E. B. Yakimov, A. Y. Polyakov, I. V. Shchemerov, A. V. Chernykh, A. A. Vasilev, A. I. Kochkova, In-Hwan Lee and Stephen J. Pearton, "Parasitic p-n junctions formed at V-pit defects in p-GaN", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 129,</li> </ol>	

	<p>155702 (2021).</p> <p>7. O. V. Feklisova, E. E. Yakimov and E. B. Yakimov, "Study of single-layer stacking faults in 4H-SiC by deep level transient spectroscopy", APPL. PHYS. LETT., 116, 172101 (2020).</p> <p>8. P.S. Vergeles, V.I. Orlov, A.Y. Polyakov, E.B. Yakimov, Taehwan Kim, In-Hwan Lee "Recombination and optical properties of dislocations gliding at room temperature in GaN under applied stress." Journal of Alloys and Compounds 776 181-186. (2019)</p> <p>9. Eugene B. Yakimov, Alexander Y. Polyakov, In-Hwan Lee, and Stephen J. Pearton, "Recombination properties of dislocations in GaN", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 123, 161543 (2018).</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты